# 次世代化合物半導体デバイスの機能と応用(第二期)調査専門委員会 設置趣意書

電子デバイス技術委員会

#### 1. 目的

今後のエレクトロニクスの発展に不可欠な機能の多様化を実現するために、化合物半導体デバイスの果たす役割は極めて大きい. III-V 族を中心とした化合物半導体は多彩な材料系であり、これまでも Si では実現できない様々な機能を有するデバイスに応用されてきた. とりわけ、発光デバイス・高速通信デバイス応用は非常に重要であったが、昨今では、電力・エネルギーに関わる環境関連技術、テラヘルツ技術、センシング技術などにおいて、多様な機能を実現する化合物半導体デバイスが期待されている. 化合物半導体デバイスの高いポテンシャルは、こうした期待にふさわしいものであるが、産業的な観点で求められるデバイス機能や応用システムの技術的展望には、未だ不明確な点が多い. そこで、本調査専門委員会では、今後のエレクトロニクスの機能的多様化に資する化合物半導体デバイス技術に関する先行調査を行う. 材料・デバイス・システムの一貫的な視点に基づいて、目指すべき機能と応用についての展望を得ることを目指す.

#### 2. 背景および内外機関における調査活動

約半世紀にわたって世界をリードしてきた我が国の半導体産業は、厳しい国際的競争環境の下で困難な局面を迎えている。これまで高速通信応用の中核を担ってきた化合物半導体デバイスも、市場の飽和が否定できない。こうした状況のもと、我が国としては、従来の情報・通信技術分野のみならず、電力・エネルギーに関わる環境技術、テラヘルツ技術、センシング技術などの分野における革新的デバイスによって競争力を高めることが重要な課題となっている。この観点に立つと、化合物半導体は、その材料・構造の豊かな多様性によって、デバイス応用上極めて大きい可能性を有している。

電力・エネルギーに関わる環境技術においては、電気自動車などへの応用を念頭に、耐環境・高効率インバータ応用に向けたGaNデバイス やSiC デバイスに大きな期待が集まっている。それに加え、実用化の可能性は未知数であるものの、超高耐圧を特徴とする酸化ガリウムデバイスについても、国内の公的研究機関が研究開発を牽引している。また、高効率無線給電のための化合物半導体デバイスに対する期待も大きく、デバイス・応用システムについて国内の産官学連携研究が進んでいる。さらに、太陽光発電デバイスの超高効率化のためには、広い波長範囲に対応できる化合物半導体が必須であり、研究が加速し始めている。一方、テラヘルツ技術は、ミリ波領域と光領域の間にある未開拓領域の技術として、通信・センシングなど広い分野での応用が期待されている。ミリ波デバイスとして開発されてきた InP 系デバイスの性能はテラヘルツ領域に到達しつつあり、また、量子カスケードレーザや共鳴トンネルダイオードなど量子効果を利用したデバイスのテラヘルツ領域応用が期待されている。センシング技術については、上述のテラヘルツセンシングに加え、中赤外・遠赤外光センシングや磁気センシングのための狭ギャップ化合物半導体デバイスの開発が進められている。

2015年10月に設置された「次世代化合物半導体デバイスの機能と応用」調査専門委員会では、上記をふまえ、材料・デバイス・システムの一貫的な視点に基づいて化合物半導体デバイスの機能と応用を展望してきたが、こうした調査を我が国の産業力強化につなげることの重要性は益々高まっている.

## 3. 調査検討事項

1) ワイドギャップ化合物半導体デバイスの機能および応用の調査 GaN, SiC, 酸化ガリウムによるデバイスは何れも高いポテンシャルを有しているが、求められ る性能項目は多岐にわたり、コストも実用化の成否を決める大きな要素である. このことをふ まえ、これらデバイスのポテンシャル、デバイスに適した機能と応用について調査し、展望を得る.また、無線給電における化合物半導体デバイスの役割やシステムのあり方についての調査を進める.

2) テラヘルツ化合物半導体デバイスおよび応用システムの調査 産業として有望なテラヘルツ領域での応用を展望しながら、InP系デバイス、量子カスケード レーザ、共鳴トンネルダイオードなどのデバイスのポテンシャルと、これらのデバイスを利用 した応用システムについての調査を進める.

3) センシング化合物半導体デバイスおよび応用システムの調査 テラヘルツセンシング,中赤外・遠赤外光センシング,磁気センシングのための化合物半導体 デバイスについての調査を進めながら,これらの技術領域の市場を広げるために必要な応用シ ステムについての調査を進める.

# 4. 予想される効果

環境関連技術,高速通信技術,テラヘルツ技術,センシング技術などの分野における産業創出に資する化合物電子デバイスに関する調査を通じて,今後の我が国の産官学全体の効率的研究開発の指針と展望が得られることが期待される.

# 5. 調査期間

平年 29 年 (2017 年) 10 月 - 平成 31 年 (2019 年) 9 月

## 6. 活動予定

委員会5回/年,研究会1回/年

# 7. 報告形態

部門大会企画セッションでの発表をもって報告とする.